

Aufgabe 1: Elektrische Ladung

(a)

Coulombsche Gesetz:

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$$

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$$

mit

$$F = \frac{C}{V}$$

 ε_r : Dielektrizitätszahl, Relative Permittivität

z.B. Vakuum: $\varepsilon_r = 1$

$$F = \frac{10^{-6}C \cdot 10^{-6}C}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{C}{Vm} \cdot 1 \cdot (100cm)^2} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,854} \cdot \frac{CV}{m} = 8,99 \cdot 10^{-3} \frac{CV}{m}$$

$$= 8,99 \cdot 10^{-3} N$$

(b)

(c)

$$F_1 - F_2 = 0$$

$$F_1 = \frac{q \cdot Q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1^2}$$

$$F_2 = \frac{q \cdot Q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2^2}$$

$$r_1 = r_2 \rightarrow x = 0$$

(d)

$$F = q \cdot E$$

$$0 = q \cdot E \land q \neq 0 \Rightarrow E = 0$$

(e)

$$U = 0$$

gleichgroße Ladungen



Aufgabe 2: Elektrisches Feld

1.

$$U = \int_{A}^{B} E \ ds$$

$$U_{AB}=0$$

2.

$$U_{AD} = \int_{0}^{l} E \, ds = E \cdot s|_{0}^{l} = E \cdot l$$

3.

$$U_{AC} = U_{AD} + U_{DC} = E \cdot l + 0 = E \cdot l$$

$$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 0 + E = E \cdot l$$

$$U_{AC} = \int_{A}^{C} \vec{E} d\vec{s} = \int_{A}^{C} {\binom{E_x}{E_y}} {\binom{dx}{dy}} = \int_{A}^{C} E_x dx + E_y dy$$

Da

$$E_y = 0$$

$$\Rightarrow U_{AC} = \int_{0}^{l} E_{x} dx = E_{x} dx|_{0}^{l} = E \cdot l$$

4.

$$U_{AD} = \int_{0}^{l} E_{0} ds = E_{0} ds |_{0}^{l} = 30 \frac{V}{m} \cdot 2m = 60V$$

5.

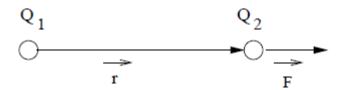
Richtig sind 2) 4) 5)





Aufgabe 3: Elektrostatik

(a) $\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \cdot \vec{e}_r$



(b)

$$\vec{F}_1 = \frac{Q_1 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 25} \cdot {4/5 \choose 3/5} = \frac{Q_1 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot {4 \choose 3}$$

$$\vec{F}_2 = \frac{Q_2 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 25} \cdot \begin{pmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{pmatrix} = \frac{Q_2 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_3 = \frac{Q_3 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 25} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -5/5 \end{pmatrix} = \frac{Q_3 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix}$$

(c)

$$\begin{split} \vec{F}_{ges} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \\ &= \frac{Q_1 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot \binom{4}{3} + \frac{Q_2 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot \binom{4}{-3} + \frac{Q_3 \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot \binom{0}{-5} \\ &= \frac{Q \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot \left[\binom{4}{3} + \binom{4}{-3} + \binom{0}{-5} \right] \\ &= \frac{Q \cdot q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \cdot 125} \cdot \binom{8}{-5} \end{split}$$

Aufgabe 4: Magnetisches Feld

a) Wie viele Elektronen fließen pro Sekunde durch L_1 wenn der Strom $I_1 = 2A$

$$e = -1,602 \cdot 10^{-19}C$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{n \cdot e}{\Delta t}$$

$$\Leftrightarrow n = \frac{2A \cdot 1s}{1,602 \cdot 10^{-19}C} = 1,248 \cdot 10^{19}$$

Berechnen Sie die magnetischen Feldstärke $\overrightarrow{H_1}$ und $\overrightarrow{H_2}$ in einem beliebigen Punkt (x, y) für die jeweiligen Leiter L₁ und L₂. Hierfür muss die Formel von $\overrightarrow{H}_{Allg}$ so angepasst werden, dass der betrachtete Leiter in den Ursprung verschoben wird.

b)
$$\vec{H}_{Allg} = \frac{I}{2\pi\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{pmatrix} = \frac{I}{2\pi(x^2 + y^2)} \cdot {y \choose x}$$

- 1. Berechnung der magnetischen Feldstärke $\overrightarrow{H_1}$ und $\overrightarrow{H_2}$ in einem Punkt (x, y) für die Leiter L₁ und L₂
 - Die magnetische Feldstärke kann jetzt für die einzelnen Leiter berechnet werden, indem für die x und y -Koordinate die Positionen des Punktes P eingesetzt werden
 - Verschiebung der Leiter in den Ursprung
 - Leiter1: x entspricht x-a
 - Leiter2: x = x (-a) = x + a

Die y-Koordinate der beiden Leiter ist 0 -> Keine Verschiebung notwendig

$$\vec{H}_{1} = \frac{I_{1}}{2\pi((x-a)^{2} + y^{2})} \cdot {y \choose x-a}$$

$$\vec{H}_{2} = \frac{I_{2}}{2\pi((x+a)^{2} + y^{2})} \cdot {y \choose x+a}$$

2. Superposition der Feldstärken: $\overrightarrow{H}_{ges} = \overrightarrow{H_1} + \overrightarrow{H_2}$

$$\vec{H}_{ges} = \frac{I_1}{2\pi((x-a)^2 + y^2)} \cdot {y \choose x-a} + \frac{I_2}{2\pi((x+a)^2 + y^2)} \cdot {y \choose x+a}$$

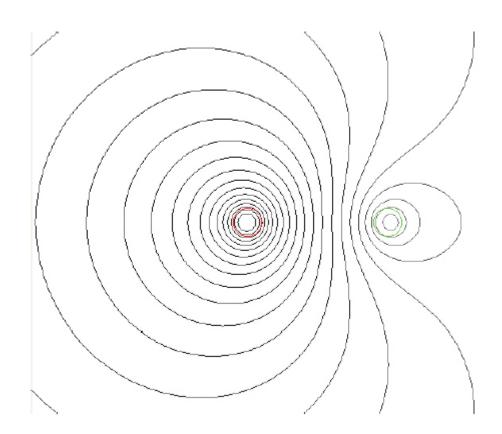




c) P(5/2/0), a=3m

$$\begin{split} \vec{H}_{ges} &= \frac{2A}{2\pi((5-3)^2+2^2)} \cdot \binom{-2}{5-3} + \frac{2A}{2\pi((5+3)^2+2^2)} \cdot \binom{-2}{5+3} \\ &= \frac{1A}{8\pi} \cdot \binom{-2}{2} + \frac{1A}{68\pi} \cdot \binom{-2}{8} \approx \binom{-0.09}{0.12} \frac{A}{m} \\ \vec{H}_{ges} &= \sqrt{(-0.09)^2 + (0.12)^2} \approx 0.148 \frac{A}{m} \\ B &= 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 0.148 \frac{A}{m} = 0.186 \,\mu\text{T oder } 0.186 \cdot 10^{-6}\text{T} \end{split}$$

- d) Zeichnen Sie qualitativ den Verlauf für \vec{H} für $\frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{2}$
 - I2 ist doppelt so groß wie I1
 - Die Ströme fließen in unterschiedliche Richtungen





Aufgabe 5: Taschenlampe

- a.) Ersatzschaltbild
- b.) Eine ideale Spannungsquelle stellt einem System eine konstante Spannung zur Verfügung, d.h. unabhängig von der Last. Eine reale Batterie würde sich entladen. Die Spannung ändert sich mit der Zeit, der Strom hängt von der angeschlossenen Last ab.
- c.)
 Ohmsches Gesetz:

$$U = R \cdot I$$

$$U = 4.5V$$

$$R = 1.2k\Omega = 1.2 \cdot 10^3 \Omega = 1200\Omega$$

$$I = \frac{4,5V}{1200\,O} = 3,75 \cdot 10^{-3}A = 3,75mA$$

- d.) Durch den Widerstand (Stöße der Elektronen) wird elektrische Energie in Wärme und Licht umgesetzt.
 - Wird an eine Halbleiterdiode eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt, wandern Elektronen von der n-dotierten Seite zum p-n-Übergang. Nach Übergang zur p-dotierten Seite geht das Elektron dann in das energetisch günstigere Valenzband über. Dieser Übergang wird Rekombination genannt, denn er kann auch als Zusammentreffen von einem Elektron im Leitungsband mit einem Defektelektron (Loch) interpretiert werden. Die bei der Rekombination frei werdende Energie wird in einem direkten Halbleiter meist direkt als Licht (Photon) abgegeben.



Aufgabe 6: Kapazität

a) Wie groß ist die Kapazität des Kondensators in pF?

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$$

$$\varepsilon_r = 3$$

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m} \cdot 3 \cdot \frac{4mm^2}{1\mu m} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m} \cdot 3 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6} m^2}{1 \cdot 10^{-6} m}$$
$$= 106,248 pF$$

- b) Wie kann man die Kapazität des Kondensators steigern, ohne die Abmessungen der DRAM-Zelle zu verändern?
 - Die Kapazität kann durch die Verwendung eines Dielektrikums mit besseren isolierenden Eigenschaften ($\varepsilon_r > 3$) gesteigert werden, ohne die Abmessungen zu verändern.
- c) Wie groß ist die im Kondensator gespeicherte Ladung Q in nC?

$$Q = C \cdot U = 106,248pF \cdot 5V = 0,53nC$$

d) Wie groß ist das elektrische Feld E zwischen den Kondensatorplatten in $\frac{V}{m}$?

$$E = \frac{U}{d} = \frac{5V}{1\mu m} = 5\frac{V}{m^{-6}} = 5 \cdot 10^6 \frac{V}{m}$$



Aufgabe 7: Heizlüfter

a) Berechnen Sie den Widerstand des Lüfters und den Strom der Zuleitung!

$$P = 3000W$$

$$U = 230V$$

$$R_{Heiz} = ?$$

$$P = U \cdot I$$

$$U = R \cdot I \Leftrightarrow I = \frac{U}{R}$$

$$P = \frac{U^2}{R} \Leftrightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{(230V)^2}{3000W} = 17,63\Omega$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{3000W}{230V} = 13,04A$$

b) Berechnen Sie den Widerstand von Hin- und Rückleitung!

$$A=1,5mm^2$$

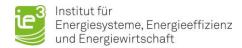
$$\rho_{Kupfer}=0,017\frac{\varOmega mm^2}{m}$$

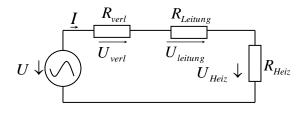
$$R_{leitung}=\rho_{Kupfer}\cdot\frac{l}{A}=0,017\frac{\varOmega mm^2}{m}\cdot\frac{5m}{1,5mm^2}=0,0567\varOmega=56,7\cdot10^{-3}\varOmega=56,7m\varOmega$$

 $l = 2.5m \cdot 2 = 5m$

- c)
 Relativ großer Strom I, d.h. viele Elektronen $\begin{array}{c}
 l \uparrow \Rightarrow R \uparrow \\
 A \downarrow \Rightarrow R \uparrow
 \end{array}$ viele Stöße/Reibung \rightarrow Wärme \rightarrow Schmelzen der Isolation
- d) Welche Leistung wird im Verlängerungskabel umgesetzt? Ist die Verwendung des Verlängerungskabels zulässig?







$$P = U \cdot I$$

$$U = R \cdot I$$

$$R_{verl} = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0.017 \frac{\Omega mm^2}{m} \cdot \frac{2 \cdot 8m}{0.75 mm^2} = 0.361 \Omega$$

$$R_l = R_{verl} + R_{Heiz} + R_{Leitung} = 0.36 \varOmega + 17.6 \varOmega + 56.7 m \varOmega = 18.05 \varOmega$$

$$I = \frac{U}{R_l} = \frac{230V}{18,05\Omega} = 12,7A$$

$$P_{verl} = I^2 \cdot R_{verl} = (12,7A)^2 \cdot 0.36\Omega = 58W$$

Die Verwendung des Verlängerungskabels ist nicht zulässig!



Aufgabe 8: Induktivität

a) Schaltzeichen einer Induktivität



b) Wie heißt das entsprechende elektrische Bauteil?

Spule, Drossel

c) Welche Einheit hat die Induktivität im internationalen Einheitensystem?

$$[L] = \frac{Vs}{A} = H$$
 Henry

Die Magnetische Flussdichte leitet sich aus der Kraft auf bewegte Ladungen ab → Materialabhängig.

d) Welchen Zusammenhang haben Strom und Spannung einer Induktivität?

Induktivitäten

$$1. n\Phi = L \cdot i$$

2.
$$U = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$3. W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

1.
$$[Wb] = [H] \cdot [A]$$

=> $[Vs] = \left[\frac{Vs}{A}\right] \cdot [A]$

2.
$$[V] = [H] \cdot \frac{d[A]}{dt}$$

=> $[V] = \left[\frac{Vs}{A}\right] \cdot \frac{[A]}{[s]}$

Kapazitäten

1.
$$Q = C \cdot u$$

$$2. i = C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$3. W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

In Einheiten:

1.
$$[C] = [F] \cdot [V]$$

=> $[As] = \left[\frac{As}{V}\right] \cdot [V]$

2.
$$[A] = [F] \cdot \frac{d[V]}{dt}$$

=> $[A] = \left[\frac{As}{V}\right] \cdot \frac{[V]}{[s]}$



3.
$$[Ws] = \frac{1}{2} \cdot [H] \cdot [A^2]$$

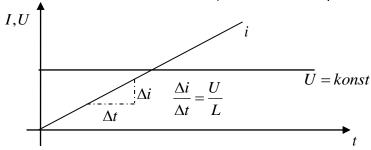
 $\Rightarrow [Ws] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{Vs}{A}\right] \cdot [A^2]$
 $\Rightarrow [Ws] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{Ws}{A^2}\right] \cdot [A^2]$

3.
$$[Ws] = \frac{1}{2} \cdot [F] \cdot [V^2]$$

 $\Rightarrow [Ws] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{As}{V}\right] \cdot [V^2]$
 $\Rightarrow [Ws] = \frac{1}{2} \cdot [As] \cdot [V]$
 $\Rightarrow [Ws] = \frac{1}{2} \cdot [As] \cdot \left[\frac{W}{A}\right]$

Die Spannung ist proportional zur Stromänderung

e) Stromverlauf an einer Induktivität (mit konstanter Spannung)



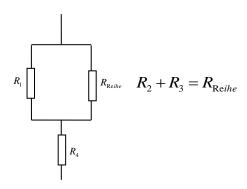
f) Stromverlauf an einer Induktivität





Aufgabe 9: Netzwerk

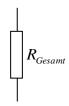
1. Gesamtwiderstand der Anordnung berechnen



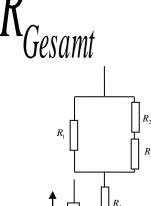
$$\frac{1}{R_{Parallel}} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{Reihe}}$$

$$R_{Parallel} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2} + R_{3}}$$

$$R_{4} \quad R_{Parallel} = \frac{(R_{2} + R_{3}) \cdot R_{1}}{R_{1} + R_{2} + R_{3}}$$



$$R_{Gesamt} = R_4 + R_{Parallel}$$
 $R_{Gesamt} = R_4 + \frac{(R_2 + R_3) \cdot R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$



2.
$$U = RI \Rightarrow I = \frac{U_0}{R_{Gesamt}}$$

$$I_4 = ?$$



Knotengleichungen aufstellen:

$$A:I=I_1+I_2$$

$$B:I_1+I_2=I_4=I$$

$$U_4=R_4\cdot I$$

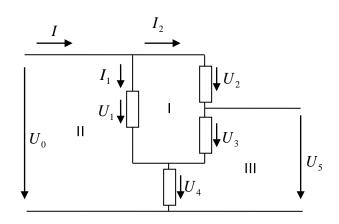
3.
$$A: I - I_1 - I_2 = 0$$
 4.
$$U_1 = R_1 \cdot I_1$$

$$U_1 = ?$$

Maschengleichungen aufstellen:

$$\begin{split} U_1 + U_4 - U_0 &= 0 \\ U_1 &= U_0 - U_4 \\ I_1 &= \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_0 - U_4}{R_1} \\ I_2 &= ? \\ I - I_1 - I_2 &= 0 \\ I_2 &= I - I_1 \end{split}$$

I. $U_1 - U_3 - U_2 = 0$



5.

$$U_5 - U_4 - U_3 = 0 \Rightarrow U_5 = U_4 + U_3 \quad \text{III}.$$

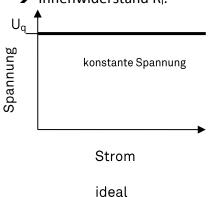
$$U_3 = R_3 I_3 = R_3 I_2$$

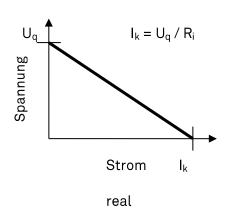




Zusatzaufgabe: Quellen

- a) Beschreibende Größen einer realen Spannungsquelle:
 - → Leerlaufspannung U_q
 - → Innenwiderstand R_i.

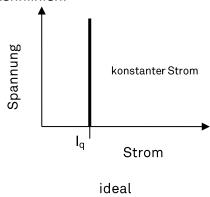


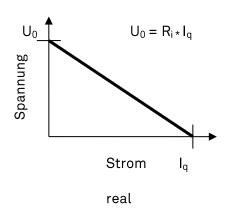


Grundsätzlicher Unterschied: Bei einer idealen Spannungsquelle ist die bereitgestellte Spannung lastunabhängig. Bei einer realen Spannungsquelle ist die Spannung abhängig von der angeschlossenen Last.

- b) Beschreibende Größen einer realen Stromquelle:
 - → Kurzschlussstrom I_q
 - → Innenwiderstand R_i.

Kennlinien:





Grundsätzlicher Unterschied: Bei idealer Stromquelle ist der Strom lastunabhängig, bei realer Stromquelle abhängig von angeschlossener Last.

c)

	Reale Spannungsquelle	Reale Stromquelle
Innenwiderstand	Ri	R _i
Leerlaufspannung	Uq	$U_0 = R_i * I_q$
Kurzschlussstrom	$I_k = U_q / R_i$	Iq

d)
$$U_q = 5 \text{ V}, R_i = 50 \Omega$$

$$\rightarrow$$
 $I_q = I_k = U_q / R_i = 0.1 A$

→ Zeichnung

e)
$$I_q = 1 \text{ A}, R_i = 100 \Omega$$

$$\rightarrow U_0 = R_i * I_q = 100 \text{ V}$$

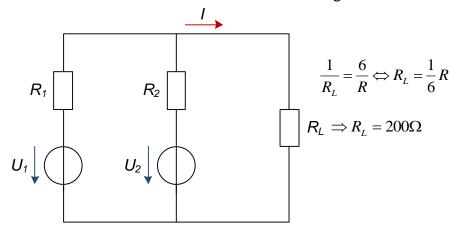
→ Zeichnung





Aufgabe 10: Quellenumwandlung und Überlagerungssatz

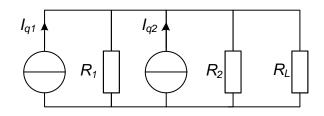
a) Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild der Anordnung.



Wenn
$$R_1 = R_2$$
 ist $R_{Ges} = \frac{R}{2}$, bei 6 Widerständen ist also $R_{Ges} = \frac{R}{6}$

b) Bestimmen Sie den Strom *I*, der in die Last hineinfließt, durch das Umwandeln von Quellen und Zusammenfassen von Elementen.

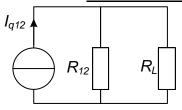
1. Umwandlung in äquivalente Stromquelle



$$I_{q1} = \frac{U_{q1}}{R_{i1}} = \frac{4,5V}{0,2\Omega} = 22,5A$$

$$I_{q2} = \frac{U_{q2}}{R_{i2}} = \frac{4.5V}{0.4\Omega} = 11.25A$$

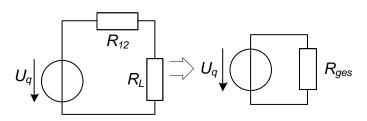
2. Zusammenfassung der Stromquellen



$$I_{q12} = I_{q1} + I_{q2} = 33,75A$$

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{0.2\Omega \cdot 0.4\Omega}{0.2\Omega + 0.4\Omega} = 0.1\overline{3}$$

3. Umwandlung in äquivalente Spannungsquelle, Zusammenfassung der Widerstände und Bestimmung von I



$$U_q = R_{12} \cdot I_q = 0.1\overline{3} \cdot 33,75A = 4.5V$$

$$R_{ges} = R_{12} + R_L = 200,13\Omega$$

$$I = \frac{U_q}{R_{ges}} = \frac{U_0}{\frac{1}{6}R + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{4,5V}{200,1\overline{3}\Omega} = 22,4mA$$

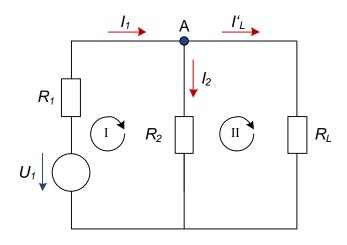




c) Bestimmen Sie den Strom *I*, der in die Last hineinfließt, durch Anwendung des Überlagerungssatzes.

Ziel ist Bestimmung von I_L' und I_L'' um u_1 , u_2 und R zu berechnen.

1) Deaktivierung von U_2 zur Berechnung der Wirkung von U_1



Knotensatz A: $I_1=I_2+I'_{L1}$

Masche I:
$$-U_1 + R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 = 0 \Leftrightarrow U_1 = R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2$$

Masche II:
$$I_2 \cdot R_2 = I'_{L1} \cdot R_L \iff I_2 = I'_{L1} \frac{R_L}{R_2}$$

A in I:
$$U_1 = R_1 \cdot (I_2 + I_L) + R_2 \cdot I_2 = R_1 \cdot I_2 + R_1 \cdot I_L + R_2 \cdot I_2$$

$$=> (R_1 + R_2) \cdot I_2 + R_1 \cdot I_L = U_1$$

Mit II folgt:
$$(R_1 + R_2) \cdot \frac{R_L}{R_2} \cdot I'_L + R_1 \cdot I'_L = U_1$$

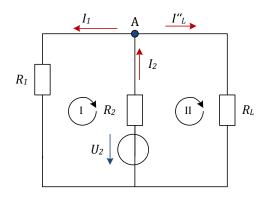
$$\Leftrightarrow I'_{L} \left[(R_{1} + R_{2}) \cdot \frac{R_{L}}{R_{2}} + R_{1} \right] = U_{1}$$

$$\Leftrightarrow I'_{L} = \frac{U_{1}}{\left[(R_{1} + R_{2}) \cdot \frac{R_{L}}{R_{2}} + R_{1} \right]} = \frac{U_{1} \cdot R_{2}}{\left[(R_{1} + R_{2}) \cdot R_{L} + R_{1}R_{2} \right]}$$





2) Deaktivierung von U_1 zur Berechnung der Wirkung von U_2



Knoten A: $I_1 = I_2 - I_L^{"}$

Masche I: $0 = U_2 - R_2 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_1$ (Stromrichtung von I_1 beachten!)

 $\text{Masche II:} \qquad 0 = I_L^{"} \cdot R_L + I_2 \cdot R_2 - U_2 \qquad umformen => \quad I_2 = \frac{U_2 - I_L^{"} \cdot R_L}{R_2}$

A bzw. I₁ in Masche I ersetzen:

$$0 = U_2 - R_2 \cdot I_2 - R_1 (I_2 - I_L^{"})$$

$$0 = U_2 - R_2 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_2 + R_1 \cdot I_L^{"}$$

$$0 = U_2 - I_2 \cdot (R_1 + R_2) + R_1 \cdot I_L^{"}$$

*I*₂ <u>ersetzen:</u>

$$0 = U_{2} + \left(\frac{I_{L}^{"} \cdot R_{L} - U_{2}}{R_{2}}\right) \cdot (R_{1} + R_{2}) + R_{1} \cdot I_{L}^{"}$$

$$0 = U_{2} + \frac{I_{L}^{"} \cdot R_{L} \cdot R_{1}}{R_{2}} + \frac{I_{L}^{"} \cdot R_{L} \cdot R_{2}}{R_{2}} - \frac{U_{2} \cdot R_{1}}{R_{2}} - \frac{U_{2} \cdot R_{2}}{R_{2}} + R_{1} \cdot I_{L}^{"}$$

$$0 = \frac{I_{L}^{"} \cdot R_{L} \cdot R_{1}}{R_{2}} + I_{L}^{"} \cdot R_{L} - \frac{U_{2} \cdot R_{1}}{R_{2}} + R_{1} \cdot I_{L}^{"} \quad \middle| \cdot R_{2}$$

$$0 = I_{L}^{"} \cdot R_{L} \cdot R_{1} + I_{L}^{"} \cdot R_{L} \cdot R_{2} - U_{2} \cdot R_{1} + R_{1} \cdot R_{2} \cdot I_{L}^{"}$$

$$U_{2} \cdot R_{1} = I_{L}^{"} (R_{L} \cdot R_{1} + R_{L} \cdot R_{2} + R_{1} \cdot R_{2})$$

$$U_{2} \cdot R_{1} = I_{L}^{"} (R_{L} (R_{1} + R_{2}) + R_{1} \cdot R_{2})$$

$$\Rightarrow I_{L}^{"} = \frac{U_{2} \cdot R_{1}}{(R_{L} (R_{1} + R_{2}) + R_{1} \cdot R_{2})}$$

3) Überlagern der Teilströme





$$I=I'_L+I''_L$$

$$=\frac{U_{1}\cdot R_{2}+U_{2}\cdot R_{1}}{\left[(R_{1}+R_{2})\cdot R_{L}+R_{1}R_{2}\right]}=\frac{U_{0}(R_{2}+R_{1})}{\left[(R_{1}+R_{2})\cdot R_{L}+R_{1}R_{2}\right]}=\frac{U_{0}}{\left[R_{L}+\frac{R_{1}\cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\right]}$$

→ Die Lösung entspricht der aus Aufgabenteil b).

$$\Rightarrow \frac{U_0}{[R_L + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}]} = \frac{4.5 \text{ V}}{200 \Omega + \frac{0.2\Omega \cdot 0.4\Omega}{0.6\Omega}} = 0.0224 \text{ A} = 22.4 \text{ mA}$$



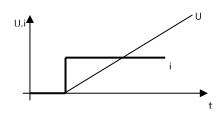
Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft

Aufgabe 11: Gemischte Schaltungen

1. Kondensator

2. Farad
$$1F = 1\frac{C}{V}$$

3.
$$i_c(t) = C \frac{du(t)}{dt} \Rightarrow u(t) = \frac{1}{C} \int i_c dt$$



4. Maschengleichung:

$$\begin{aligned} u_c(t) - u_0 + u_R &= 0 \\ u_R &= I_R \cdot R_i = i_c(t) \cdot R_i = R_i \cdot C \frac{du_c(t)}{dt} \\ u_c(t) - u_0 + R_i \cdot C \frac{du_c(t)}{dt} &= 0 \\ R_i \cdot C \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) &= u_0 \end{aligned}$$

Allgemeiner Ansatz:

$$u_c(t) = A \cdot e^{\lambda t} + u_0$$

Einsetzten in Maschengleichung

$$R_{i} \cdot C \cdot A \cdot \lambda \cdot e^{\lambda t} + A \cdot e^{\lambda t} + u_{0} = u_{0}$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{1}{R_{i}C}$$

Anfangsbedingung:

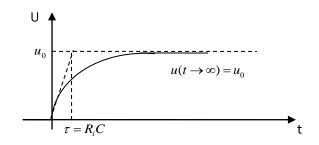
$$u_c(0) = 0 = Ae^0 + u_0 \implies A = -u_0$$

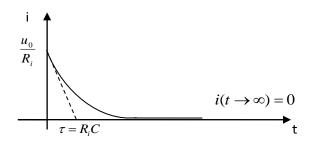
Lösung:

$$u_c(t) = -u_0 e^{-\frac{1}{R_i C}t} + u_0 = u_0 (1 - e^{\frac{-t}{R_i C}t})$$

$$i_c(t) = C \frac{u_0}{R_i C} e^{-\frac{1}{R_i C}t} = \frac{u_0}{R_i} e^{-\frac{1}{R_i C}t}$$

5.





Aufgabe 12: Diode

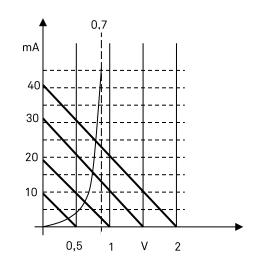
a) Maschengleichung:

$$U_A - U_E + R \cdot I = 0$$
$$I = I_D = \frac{1}{R} (U_E - U_A)$$

b) Arbeitsgeraden:

$$U_E\rangle 2V$$
: $U_A \rightarrow 0.7$

Typisch für Si-Dioden



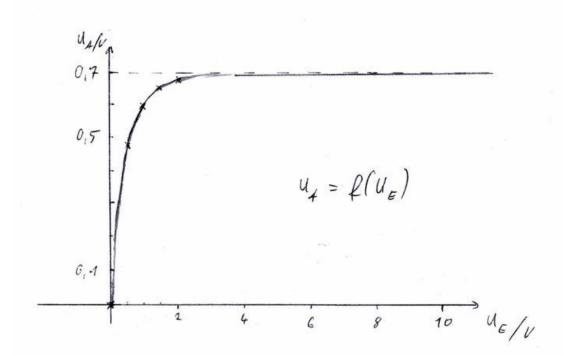
c) Ablesen der Arbeitspunkte:

$U_{\scriptscriptstyle E}$ in V	$U_{\scriptscriptstyle A}$ in V
0	0
0,5	0,42
1	0,6
1,5	0,66
2	0,68

Diagramme zu c) und d):







4. Jue Jan Ju

Spanning; abfall iber $R_M: U_A = \frac{R_M}{R + R_M} E = 0.0588 U_E$ 0.7 0.5 0.1 2 4 6 8 10 12 12





Aufgabe 13: Halbleiter

- a) Sind reine Halbleitermaterialien wie z.B. Silizium leitfähig?
 - Nein, alle Elektronen werden für die Elektronenpaarbindung benötigt.
 - Keine frei beweglichen Elektronen sind für den Stromfluss verfügbar.
 - IV-Halbleiter (z.B. Silizium)
 - III/V-Halbleiter (z.B. GaAs)
- b) Was versteht man unter der Dotierung eines Halbleiters?
 - Ersetzen von Atomen des Halbleitergitters durch Fremdatome (siehe Folie)
 - Nur etwa jedes 100 Millionste Atom wird ersetzt.
- c) Erklären Sie den Stromfluss bei n-dotiertem Material.
 - Durch die n-Dotierung stehen im Gitterverbund "freie Elektronen" zur Verfügung.
 - Das Elektron kann sich im Halbleitergitter fortbewegen -> Stromfluss
 - Bei p-Dotierung: Löcherleitung. Elektronen springen von Loch zu Loch -> Stromfluss
- d) Erklären Sie die Funktionsweise eines npn-Transistors.
 - Halbleiterindustrie: Kombination von von verschieden dotierten Materialien
 - 1. Ein pn-Übergang: Diode (Folie Diode)

p-Seite: Anode

n-Seite: Kathode

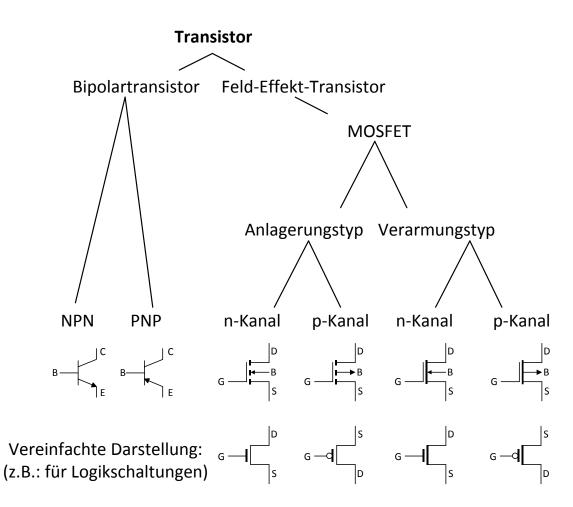
- 2. Zwei pn-Übergänge: Transistor (Folie Transistor)
 - pnp-Transistor: Der stark dotierte Emitter emittiert Löcher, die die dünne Basis durchqueren
 - npn-Transistor: Der stark dotierte Emitter emittiert Elektronen, die die dünne Basis durchqueren





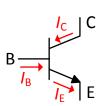
Aufgabe 14: Transistor

a)



b)
Basis (B), Kollektor (C), Emitter (E)
FET: Gate (G), Drain (D), Source (S), Bulk (B)

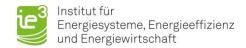
c)



 $I_{\scriptscriptstyle E}$ ist am größten, weil $I_{\scriptscriptstyle E}=I_{\scriptscriptstyle B}+I_{\scriptscriptstyle C}$ $I_{\scriptscriptstyle B}$ ist am kleinsten, weil $U_{\scriptscriptstyle B}$ mittlere Spannung (Steuerstrom)

d)





$$\begin{split} &U_i = 0V \Rightarrow I_B = 0A \Rightarrow \text{Transistor sperrt} \Rightarrow I_E = 0A, I_C = 0A \\ &U_A - U_V - U_{RL} = 0 \land U_{RL} = I_{RL} \cdot R_L \\ &I_C = 0 \Rightarrow I_{RL} = 0 \Rightarrow U_{RL} = 0 \\ \Rightarrow &U_A = U_V \end{split}$$

e)
$$U_{i} = 5V \Rightarrow I_{RV} \neq 0A \Rightarrow U_{RV} \neq 0$$

$$U_{i} - U_{BE} - U_{RV} = 0$$

$$U_{BE} \neq 0 \Rightarrow I_{B} \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{Transistor Leitet} \Rightarrow \text{hohe Leitf\"{a}higkeit} \Rightarrow \text{Kein Widerstand (\approx 0)}$$

$$\Rightarrow U_{A} = 0$$

f) Versorgungsspannung $U_{\it R}$ am Emitter \Rightarrow konstante Spannung \Rightarrow Emitterschaltung Aus d.) und e.)

$$U_i = 0V \mid 0 \Rightarrow U_A = U_V \mid 1$$

$$U_i = 5V \mid 1 \Rightarrow U_A = 0V \mid 0$$

⇒Invertierend: Inverter



Aufgabe 15: Logische Schaltungen

Durch welche logische Verknüpfung ergibt sich die Ausgangsgröße y aus den a) beiden Eingangsgrößen x_1 und x_2 ?

Logische Verknüpfungen:

AND: $y = x_1 \wedge x_2$

NOT: $y = \overline{x_1}$

• NAND: $y = \overline{x_1 \wedge x_2}$

• OR: $y = x_1 \lor x_2$

• NOR: $y = \overline{x_1 \vee x_2}$

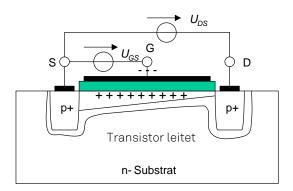
EXOR: $y = (x_1 \wedge \overline{x_2}) \vee (\overline{x_1} \wedge x_2)$ Comparator: $y = (x_1 \wedge x_2) \vee (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2})$

Transistortypen:

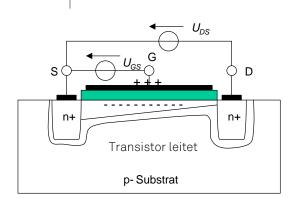
MOSFET Anlagerungstyp

p-Kanal





n-Kanal



Einteilung der Schaltung in drei Bereiche:

- 1. Serienschaltung von T₅ und T₆, p-Kanal und n-Kanal
 - Wenn ein Transistor schaltet sperrt der andere
 - Die Transistoren schalten je nach Potenzial am Punkt P (S von T₂ und D von T₃)

Р	T ₆	T ₅	у
$U_B = 1$	I	S	0V = 0
0V ≙ 0	S		$U_{\scriptscriptstyle B} = 1$

• NOT (Inverter): $y = \overline{P}$

2. Parallelschaltung von T₁ und T₂, beide p-Kanal

X ₁	T ₁	X2	T ₂	m
0	1	0	I	$U_{\scriptscriptstyle B} = 1$
1	S	0	I	$U_B = 1$
0	1	1	S	$U_{\scriptscriptstyle B} = 1$
1	S	1	S	$\neq U_B$

■ Wenn ein Transistor schaltet, liegt an P die Spannung U_B an.

3. Serienschaltung von T₃ und T₄, beide n-Kanal

X ₁	T ₃	X2	T ₄	m
1	1	1	ı	0
0	S	0	S	≠0
1	S	0	S	≠0
0	S	1		≠ 0

4. Schaltung 2. und Schaltung 3.:

X ₁	<i>X</i> ₂	2.	3.	Р
0	0	I	S	$U_{\scriptscriptstyle B} = 1$
1	0	1	S	$U_B = 1$
0	1	I	S	$U_B = 1$
1	1	S	I	0

■ => NAND: $P = \overline{x_1 \wedge x_2}$

Insgesamt ergibt sich aus dem NAND und der NOT Verknüpfung eine AND Verknüpfung.



Aufgabe 16: Gatterschaltung

1. Anforderungen an die Schaltung:

Aktion	Aufzug in Etage	Aufzug fährt nach
Anforderung in Etage 1 (A ₁)	0 (E ₀ =1)	oben (H)
Zielwunsch Etage 1 (F ₁)	O (E ₀ =1)	oben (H)
Anforderung in Etage 0 (A ₀)	1 (E ₁ =1)	unten (R)
Zielwunsch Etage 0 (F ₀)	1 (E ₁ =1)	unten (R)

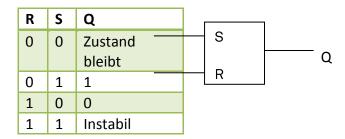
2. Kritische Punkte

- R=H=1
- H=1, falls E₁=1
- R=1, falls E₀=1
- Fahrtrichtungswechsel (Komfortgründe)

3. Speicherbedarf

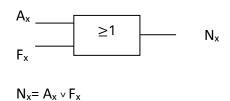
- Anforderung und Fahrtwunsch werden kurz betätigt
- Motorsteuersignale müssen über gesamter Fahrt anliegen
- Einsatz von Flip Flops

RS-Flip Flop

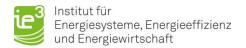


4. Aufbau der Gatterschaltung

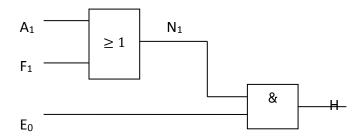
• Verknüpfung von Fahrtwunsch und Anforderung





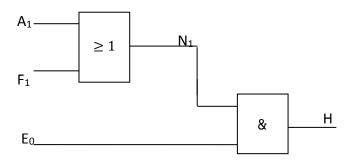


• Erzeugen des Motorsignals je nach Etage (z.B. "Hoch")



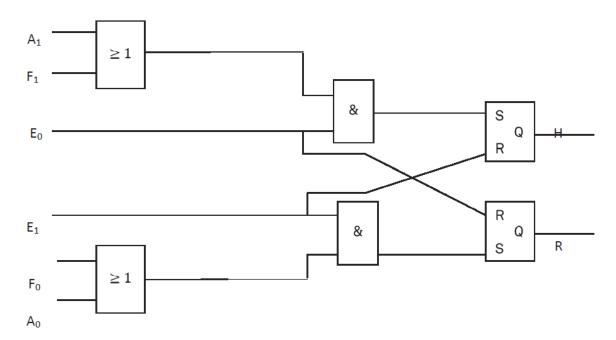
$H=E_0 \wedge N_1$

- → Kritische Punkte erledigt
- Anlegen des "H"-Signals über die gesamte Fahrt und deaktivieren wenn (Etage-) Endposition erreicht.



Fahrstuhlkontakt in E₁ setzt Flip Flop zurück.

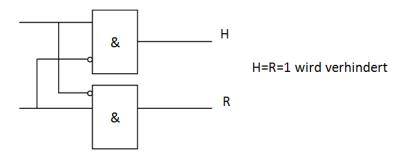
• Steuerung für Hoch und Runter sind analog







• Schutz des Motors vor Fehlern in der Schaltung







Aufgabe 17: Flipflops

a)

Т	Q_0	$\overline{oldsymbol{Q}}_{oldsymbol{0}}$	Q_1	$ar{m{Q}}_{m{1}}$	Q_2	$\overline{m{Q}}_2$	Wert Bit
0	0	1	0	1	0	1	000
1	1	0	0	1	0	1	001
0	1	0	0	1	0	1	001
1	0	1	1	0	0	1	010
0	0	1	1	0	0	1	010
1	1	0	1	0	0	1	011
0	1	0	1	0	0	1	011
1	0	1	0	1	1	0	100
0	0	1	0	1	1	0	100
1	1	0	0	1	1	0	101
0	1	0	0	1	1	0	101
1	0	1	1	0	1	0	110
0	0	1	1	0	1	0	110
1	1	0	1	0	1	0	111
0	1	0	1	0	1	0	111
1	0	1	0	1	0	1	000

b)

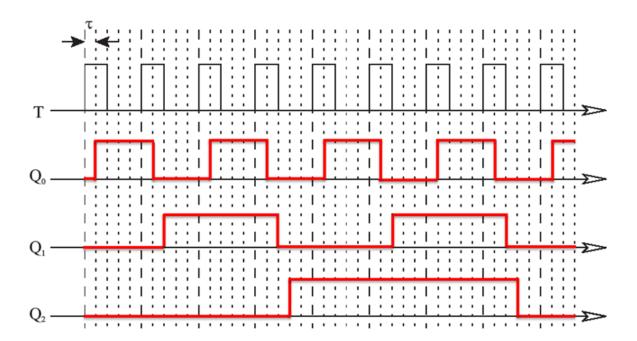
3-Bit Zähler 0-7 Niedrigstes Bit $Q_0 \rightarrow$ ganz rechts Höchstes Bit $Q_2 \rightarrow$ ganz links

2 ²	2 ¹	2 ⁰	Wert
Q_2	Q_1	Q_0	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7
0	0	0	0





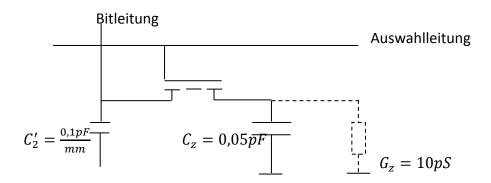
c)







Aufgabe 18: DRAM-Zelle



Siemens
$$S = \frac{1}{\Omega}$$

$$10pS = 10 \cdot 10^{-12}S$$
$$= 10 \cdot 10^{-12} \frac{1}{\Omega}$$

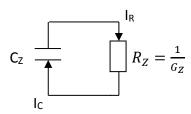
$$Q_z = 0.05pF \cdot 5V = 0.25pC$$

$$Q_{Elektron} = e = -1,602 \cdot 10^{-19} C$$

$$n_{Elektronen} = \frac{0.25 \cdot 10^{-12} C}{1.602 \cdot 10^{-19} C} \approx 1.5 Mio Elektronen$$

b) Entladung am Kondensator

Kondensator ist nicht vollkommen isoliert, zwischen den Elektroden fließt ein Strom



Kapazität
$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$I_R = -I_C$$

$$\frac{U(t)}{R_Z} = -C_Z \frac{du(t)}{dt}$$

$$G_Z \cdot u(t) = -C_Z \frac{du(t)}{dt}$$





$$\frac{du(t)}{dt} + \frac{G_Z}{C_Z}u(t) = 0 \rightarrow DGL$$

Ansatz:

$$u(t) = Ae^{\lambda t} = 0$$

$$\frac{du(t)}{dt} = A \cdot \lambda \cdot e^{\lambda t}$$

Einsetzen:

$$A \cdot \lambda \cdot e^{\lambda t} + \frac{G_Z}{C_Z} A e^{\lambda t} = 0$$
$$\lambda + \frac{G_Z}{C_Z} = 0$$

$$\lambda = -\frac{G_Z}{C_Z}$$

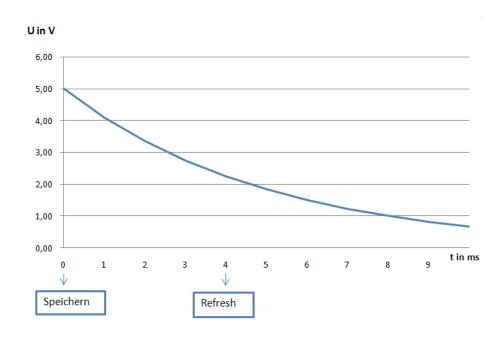
Randbedingung:

$$u(t=0) = U_B = A \cdot e^{\lambda \cdot 0} = A$$

Lösung der DGL:

$$u(t) = U_B \cdot e^{-\frac{G_Z}{C_Z}t}$$

$$u(t = 4ms) = 5V \cdot e^{-\frac{10pS}{0.05pF} \cdot 4ms} = 2,247V$$



- c) Refresh = Auslesen und Schreiben über Bitleitung
- lacktriangledown Speicherkapazität \mathcal{C}_Z ist parallel zur Bitleitungskapazität $\mathcal{C}_L = \mathcal{C}_L' \cdot l$

l = Länge der Bitleitung = Spaltenlänge





$$l = 256 \cdot 20 \mu m = 5,12 mm$$

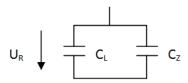
$$C_L = 0.1 \frac{pF}{mm} \cdot 5.12mm = 0.512pF$$

Parallelschaltung von Kondensatoren:

$$C_{ges} = C_L + C_Z$$

$$C_{qes} = 0.512pF + 0.05pF = 0.562pF$$

d) Vor dem Refresh ist die Spannung auf u(t=4ms) abgesunken. Jetzt wird C_L zugeschaltet und es wirkt die Gesamtkapazität.



Die Ladung Q bleibt erhalten $(Q = C_Z \cdot u(t = 4ms))$, wird jedoch umverteilt \rightarrow muss C_L aufladen.

$$Q = C_Z \cdot U_{CR} Q = C_{ges} \cdot U_R$$

$$C_Z \cdot U_{CR} = C_{ges} \cdot U_R$$

$$U_R = \frac{C_Z}{C_{ges}} U_{CR} = \frac{0.05pF}{0.562pF} \cdot 2.247V = 0.2V \triangleq 1$$

Das ist die Spannung beim Auslesen; d.h. 0,2V entspricht der logischen 1.

- e) Der Leseverstärker muss U_R von 0 unterscheiden können, also einen Unterschied von 0,2V detektieren können.
- → Sehr wenig, somit Länge der Bitleitung begrenzt.

Das kann man nicht beliebig viele Wortleitungen parallel legen, da dies die Länge und Kapazität der Bitleitung erhöht und die Spannung senkt.

Größere Speicher brauchen:

- Leistungsfähige Kondensatoren (weniger Verluste)
- Größere Kondensatoren (mehr Platz)
- Besseren Leseverstärker
- Verlustärmere Leitungen/kürzere Leitungen
- Versorgungsspannung ist fest auf 5V vorgegeben



Aufgabe 19: Elektrisch lange Leitungen und Reflexion

a) Aus Impulsmessung:

Laufzeit: 80ns (Hin- und Rücklauf)

 \rightarrow Einfache Laufzeit 40ns = τ

Aus Skript: für übliche Kabel gilt Laufzeit

$$\frac{\tau}{l} = 5 \frac{ns}{m}$$

$$\Rightarrow l = \frac{40ns}{5\frac{ns}{m}} = 8m$$

- → Fehlstelle befindet sich in einer Distanz von 8m zur Einspeisestelle
- b) Reflektierter Impuls hat negatives Vorzeichen als eingespeister Impuls
- \rightarrow Negativer Reflektionsfaktor r < 0 $r = \frac{R-Z}{R+Z}$
- → Widerstand ist kleiner als Wellenwiderstand der Leitung
 - Kurzschluss/Isolations-(versagen)schwäche X_s
- c) Leitende Verbindung = Kurzschluss $\Rightarrow r = -1$
- → Reflektierender Impuls hat die gleiche Amplitude wie ankommender Impuls nur negativ
- → Abschwächung der Amplitude nur durch Dämpfung der Leitung (von 6V auf 3V)

Gesamte absolute Dämpfung

$$a_{ges,abs} = \frac{|U_{aus}|}{|U_{ein}|} = \frac{3V}{6V} = \frac{1}{2}$$

In dB

$$a_{ges,dB} = -20\log\frac{1}{2} = 6dB$$

Dämpfung pro Meter

$$a_{m,dB} \approx \frac{6dB}{16m} = 0.375 \frac{dB}{m}$$

$$a_{m,dB} = \frac{a_{ges,dB}}{Distanz} = -\frac{20\log\frac{1}{2}}{16m}$$

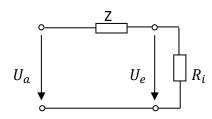


Aufgabe 20: Elektrisch lange Leitungen und Leistung

a) Umgesetzte Leistung im Empfänger ist dann maximal, wenn keine Reflexionen auftreten, da in R_i dann die gesamte Leistung umgesetzt werden kann.

$$\Rightarrow r = 0 \Rightarrow R_i = Z$$

b)



$$P = U_e \cdot I$$

$$= U_e \cdot \frac{U_e}{R_i}$$

$$= U_e \cdot \frac{U_e}{Z}$$

$$= \frac{U_e^2}{Z}$$

Beziehung zwischen \mathcal{U}_e und \mathcal{U}_a : Spannungsteiler

$$U_e = U_a \frac{R_i}{R_i + Z}$$

 $\operatorname{Mit} R_i = Z \operatorname{folgt}$

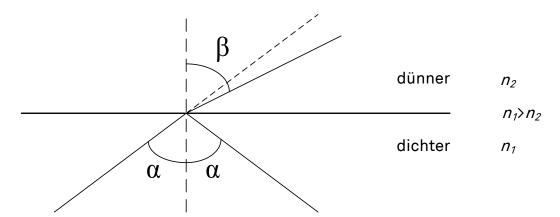
$$U_e = \frac{U_a}{2}$$

$$P = \frac{U_e^2}{Z} = \frac{U_a^2}{4Z}$$

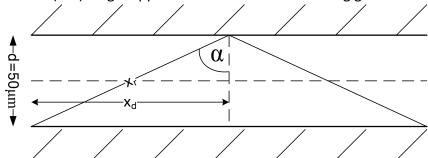


Aufgabe 21: Lichtwellenleiter

- a) Zu welcher Sorte gehört der Lichtwellenleiter aus der Abbildung?
 - Multimodenfaser, da der Kern einen Durchmesser von 50 µm hat.
 - Eine Monomodenfaser hingegen hat einen Kerndurchmesser von 3μm 8μm und kann im entsprechenden Frequenzbereich nur einen Moden führen.
- b) Mit welchem Winkel darf das Licht in die innere Faser maximal eingespeist werden, damit ausschließlich Totalreflexionen am Übergang der beiden Materialien auftreten?



- Brechungsgesetz: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$
- Totalreflexion: β=90°, sin(90°)=1
- $\Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin(0.99) = 81.89^\circ$
- c) Am Ende der Glasfaser sitzt eine positiv flankengesteuerte Elektronik. Am Anfang soll folgendes Signal eingespeist werden:
 - Je nach Einkopplung haben die Strahlen einen unterschiedlichen Weg durch die Faser. Der mit dem Winkel α eingekoppelte Strahl muss den längsten Weg, der senkrecht (90°) eingekoppelte Strahl den kürzesten Weg gehen.



- Zeitversatz durch unterschiedliche Weglänge
- Schlägt sich kritisch nieder, sobald sich zwei benachbarte Pulse überdecken.





$$T_{krit.} = T_2 - T_1 = (1 \cdot 10^{-8} - 0.1 \cdot 10^{-8})s = 9 \cdot 10^{-9} s = 9ns$$

$$\Delta x = x_r - x_d$$

$$\tan \alpha = \frac{x_d}{d} \Leftrightarrow x_d = d \tan \alpha = 50 \mu m \cdot \tan(81,89^\circ) = 350,88 \mu m$$

$$x_r = \sqrt{{x_d}^2 + d^2} = 354,42 \mu m$$

$$\Delta x = x_r - x_d = 3.54 \mu m$$

- Bei jeder Reflexion kommt es zu einem Zeitversatz von Δt
- Die Verzögerung folgt dem Wegunterschied Δx

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v}$$
, mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit $v = \frac{c}{n_1} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{1,45} = 2,069 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

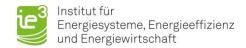
$$\Delta t = \frac{3,54 \,\mu m}{2,069 \cdot 10^8 \, \frac{m}{s}} = 1,71 \cdot 10^{-14} \, s$$

ullet Bei N Reflexionen kommt es zu einem kritischen Zeitversatz von T_{krit}

$$T_{krit} = N_{krit} \cdot \Delta t \iff N_{krit} = \frac{T_{krit}}{\Delta t} = \frac{9 \cdot 10^{-9} \, s}{1.71 \cdot 10^{-14} \, s} = 526016$$

$$l_{krit} = N_{krit} \cdot x_d = 184,6m$$





- a) Wie lang sollte die Antenne sein, damit die Feldstärke optimal in eine Spannung umgewandelt wird?
 - Die Antenne sollte der Resonanzbedingung genügen:

$$2\pi f \tau = \pi \Leftrightarrow \tau = \frac{1}{2f}$$

 Unter der Annahme, dass sich die Stromwelle mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, gilt:

$$\tau = \frac{l}{c} = \frac{1}{2f}, \text{ oder anders: Mit } \lambda = \frac{c}{f} \text{ und } l = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f}$$

$$\Leftrightarrow l = \frac{c}{2f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{2 \cdot 91, 2\frac{1}{s}} = 1,645m \, \#$$

b) Welche mittlere Leistung nimmt der Widerstand R auf? Berücksichtigen Sie zu deren Bestimmung den zeitlich konstanten Antennenfaktor $AF = \frac{E(t)}{u(t)}$.

$$P(t) = u(t) \cdot i(t) = \frac{u^{2}(t)}{R}$$

Mit
$$AF = \frac{E(t)}{u(t)} \Leftrightarrow u(t) = \frac{E(t)}{AF}$$

$$P(t) = \frac{E^{2}(t)}{AF^{2} \cdot R} = \frac{E_{0}^{2} \cdot \sin^{2}\left(2\pi f\left(t - \frac{x}{c}\right)\right)}{AF^{2} \cdot R}$$

Die Mittelung über den Sinus² ergibt $\frac{1}{2}$:

$$P(t) = \frac{E_0^2}{AF^2 \cdot 2R}$$

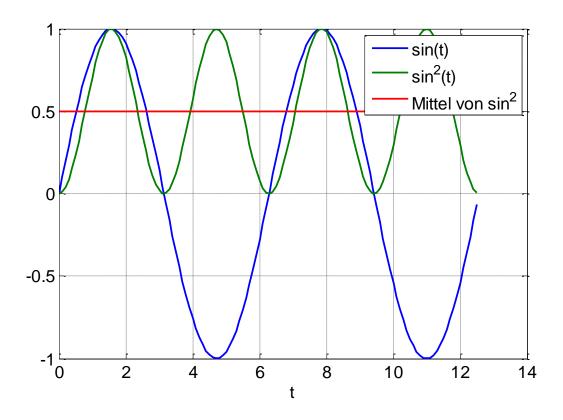




Exkurs: Wie groß ist das Mittel über sin²(x)?

1. Anschauliche Lösung:

• Die Funktion schwingt um 0,5:



2. Lösung: Integrieren

$$\overline{\sin^2 x} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin x \cdot \sin x \, dx = \frac{1}{2\pi} \pi = 0.5$$